

スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 単価表

2025年4月1日改訂

※ 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当すると判断される場合には、**50%の減額措置**を行います。
 ※ 処理の内容によっては、単価表に記載された金額よりも高くなる場合もあります。
 ※ 研究支援施設であるため、大量の試作については受け入れが難しい場合がございます。
 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

● プロセス装置 ・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2
				標準レシピを使用する場合 (円/枚)	チューニングが必要な場合 (円/時間)	同一の標準レシピを使用する場合 (~25枚) (円/FOUP)	
露光装置	1	L01-104 L01-103	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+) ArF液浸露光装置 (NSR-S610C) ※注3	120,000	360,000	1,500,000	15,000
	2	M01-08 M01-10	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) KrF露光装置 (FPA-5000ES3) ※注3 ※注4	48,000	270,000	600,000	15,000
	3	U01-102 U01-101	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) IRアライメント付i線露光装置 (FPA-5510iZs) ※注3 ※注4	48,000	270,000	600,000	15,000
塗布現像装置	4	L01-104c	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+)	54,000	270,000	675,000	15,000
	5	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4				
	6	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4	36,000	180,000	450,000	15,000
成膜装置	7	M01-04	レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)				
	8	B03-07	プラズマCVD装置 (Eagle-12) ※注4				
	9	M03-06	プラズマCVD装置 (Eagle-12 Rapidfire) ※注4				
	10	B03-06	プラズマCVD装置 (VECTOR) ※注4				
	11	F03-103	プラズマCVD装置 (VECTOR) ※注4				
	12	M03-01	高密度プラズマCVD装置 (Concept 3 Speed)				
	13	P03-101	高密度プラズマCVD装置 (MAPLE) ※注4				
	14	M03-14	High-k ALD装置 (Trias)	42,000	252,000	525,000	15,000
	15	M06-04	メタルCVD装置 (Trias-W)				
	16	F03-07	窒化膜LP-CVD装置 (TELFORMULA) ※注4				
	17	M03-03	酸化膜LP-CVD (TEOS)装置 (TELFORMULA) ※注4				
	18	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置 (DJ1226V-DF) ※注4				
	19	U03-101B	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT Staircase) ※注4				
	20	B06-101	バリアシードスパッタ装置 (Endura2 EnCoReII Ta/Cu) ※注4	60,000	180,000	750,000	15,000
	21	M06-03	メタルスパッタ装置 (COSMOS I-1201)				
	22	M06-07	メタルスパッタ装置 (ENTRON W-300) ※注4	37,000	180,000	462,500	15,000
	23	B06-102	Cuめっき装置 (SABRE NeXT)	75,000	210,000	937,500	15,000
エッチング装置	24	M02-04	Poly-Siエッチング装置 (Centura DPSII/axiom) ※注4				
	25	M02-05	メタルエッチング装置 (Centura DPSII/ASPII) ※注4	97,000	270,000	1,212,500	15,000
	26	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置 (Centura Enabler/DPS232) ※注4	60,000	270,000	750,000	15,000
	27	M02-01	酸化膜エッチング装置 (Telius SCCM-Ox/DRM-Ox) ※注4				
	28	M02-10	酸化膜エッチング装置 (Telius DRM-Ox/SCCM-Poly) ※注4				
	29	B02-01	Low-kエッチング装置 (Telius SCCM-Ox) ※注4	30,000	180,000	375,000	15,000
アッシング装置	30	F02-101	新材料エッチング装置 (U-8150) ※注4				
	31	B02-03	アッシング装置 (ICE300/RPA300) ※注4				
	32	M02-07	アッシング装置 (μ ASH300) ※注4	21,000	225,000	262,500	15,000
イオン注入装置	33	P02-105	アッシング装置 (ICE300/ μ ASH300) ※注4				
	34	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置 (EXCEED2300V)	103,000	294,000	1,287,500	15,000
熱処理装置	35	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置 (SHX)				
	36	M03-101	RTA/RTP装置 (Radiance) ※注4	112,000	270,000	1,400,000	15,000
	37	M04-02	ゲート酸化RTO/RTP装置 (Trias SPA300)	127,000	306,000	1,587,500	15,000
	38	B04-01	縦型アニール装置 (VF-5700B) ※注4				
洗浄装置	39	M04-101	縦型酸化炉 (ALPHA-303i-K) ※注4	30,000	240,000	375,000	15,000
	40	M07-15	バッチ式洗浄装置 (UW300Z) ※注4				
	41	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置 (VENUS) ※注4				
	42	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置 (SFAW-1201-008) ※注4	27,000	150,000	337,500	15,000
	43	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置 (ZETA300 BE) ※注4				
	44	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット (DGP8761SC)				
	45	M07-02	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN MP-3000) ※注4				
	46	M07-101	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4				
	47	M07-102	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4	11,000	120,000	137,500	15,000
	48	P07-105	枚葉式洗浄装置 (KC-A300CBT) ※注4				
CMP装置	49	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置 (SEZ323) ※注4				
	50	M07-09	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4				
	51	M07-12	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4	7,000	60,000	87,500	15,000
3D実装装置 (中間工程)	52	N07-101	STI, W CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M)				
	53	P07-101	Cu CMP装置 (F-REX300E)	85,000	264,000	1,062,500	15,000
	54	U07-101	Oxide CMP装置 (Reflexion LK Oxide)				
3D実装装置 (中間工程)	55	B02-101D	Si深掘りエッチング装置 (Centura Silvia) ※注4	97,000	390,000	1,212,500	15,000
	56	U03-101A	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT InViaII) ※注4	84,000	390,000	1,050,000	15,000
	57	U06-101	Cuめっき装置 (NEXX Cu ECD)	150,000	390,000	1,875,000	15,000
	58	U12-102	ウェハ接合装置 (WS3000)		390,000		15,000
	59	U07-102	ウェハエッジトリミング装置 (DFD6860) ※注4	85,000	390,000	1,062,500	15,000
	60	U07-103	Si裏面研削研磨装置 (DGP8761SC)	171,000	390,000	2,137,500	15,000

注1~4については2ページ末尾をご参照ください。

● 分析装置

・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2
				標準レシビを使用する場合 (円/枚)	チューニングが必要な場合 (円/時間)	同一の標準レシビを使用する場合(～25枚) (円/FOUP)	
重ね合わせ精度測定	61	M08-55	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM) ※注5				15,000
	62	P08-116	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM) ※注5		171,000		
薄膜解析	63	M08-07	分光エリブソ膜厚測定装置 (ASET-F5) ※注5				15,000
	64	M08-101	分光エリブソ膜厚測定装置 (ASET-F5X) ※注5				
	65	P08-108	分光エリブソ膜厚測定装置 (μSE-2500-A) ※注5		42,000		
	66	I08-101	分光エリブソ膜厚測定装置 (M-2000X) ※注5				
	67	P08-104	反射分光膜厚測定装置 (F50-EXR) ※注5				
	68	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置 (System 3272E) ※注5		60,000		
	69	F08-04	X線回折装置 (TTR In-plane XRD) ※注5		84,000		
反り・応力測定	70	B12-101	反り/膜応力自動測定装置 (128LC2G) ※注5				15,000
	71	M08-12	反り/膜応力測定装置 (128L) ※注5		36,000		
パーティクル検査	72	P08-105	パーティクル検査装置 (WM-10) ※注5				15,000
	73	P08-106	パーティクル検査装置 (WM-10) ※注5		84,000		
金属汚染検査	74	P08-107	全反射蛍光X線分析装置 (TXRF 310Fab) ※注5				15,000
	75	P08-109	自動濃縮装置 (Expert)		60,000		
		P08-113	ICP-MS質量分析装置 (NexION 2000) ※注3 ※注5				
抵抗測定	76	M08-10	シート抵抗測定装置 (RS-100) ※注5				15,000
	77	P08-102	シート抵抗測定装置 (VR300DSE) ※注5		18,000		
SEM観察	78	I08-110	測長SEM装置 (CG5000) ※注5				15,000
	79	L08-103	測長SEM装置 (CG4000) ※注5				
	80	P08-101	測長SEM装置 (S-9380 II) ※注5		45,000		
	81	P08-103	測長SEM装置 (S-9380 II) ※注5				
	82	P08-115	レビューSEM (SEMVision G6) ※注5		162,000		
光学顕微鏡	83	M08-40	光学顕微鏡 (AL3110F) ※注5				15,000
	84	M08-50	光学顕微鏡 (AL3110F) ※注5				
	85	M12-101	光学顕微鏡 (AL110) ※注5		6,000		
	86	M12-102	光学顕微鏡 (AL120) ※注5				
3D実装評価装置	87	P08-110	超音波顕微鏡 (FastLine P300) ※注5		36,000		15,000
	88	P08-111	高精度微細形状測定機 (ET4000L) ※注5				
	89	P08-112	赤外線顕微鏡システム (DSI-300SA-IR) ※注5		15,000		
	90	P08-114	赤外線拡大鏡 (BL-3000A) ※注5		6,000		

・スーパークリーンルーム外

高分解能観察	91	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡 (ORION Plus)		48,000		15,000
FIB加工/STEM	92	B08-02-01	FIB装置 (FB2100)				15,000
		AF08-402	走査透過電子顕微鏡 (HD-2700) ※注3 ※注5		36,000		
断面SEM	93	J03-117	走査電子顕微鏡 (S-4700) ※注5				15,000
	94	M08-04	走査電子顕微鏡 (S-5000) ※注5				
	95	B08-12	走査電子顕微鏡 (S-5200) ※注5		15,000		
電気特性評価	96	J03-118	フルオートプローバ (P-12XL) テスター (4073B/N9201A)				15,000
	97	M08-42	フルオートプローバ (P-12XL)				
		M10-01	テスター (4073A) ※注3		57,000		
	98	M10-05	フルオートプローバ (P-12XL) テスター (4076)				

注1 装置番号は、SCRで装置管理のために使用している番号です。

注2 技術指導費等は、装置使用方法の指導、あるいは特別な作業依頼の場合に、利用者と協議の上で適用いたします。

注3 これらの装置はセットでのご利用となります。

注4 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当し、かつ、操作方法習得済の利用者自身による夜間等流動の場合、FOUP単位料金の50%減額を行います。

注5 プロセス装置をご利用になられるの方のみに利用提供している装置です。

利用料等についての補足

◇追加料金: 追加的に必要な作業等が発生した場合に以下に記載の料金を徴収させていただきます。(共用施設等利用約款(第6条第1項第5号))

ア 改造費: 共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額。

イ 復元費: 改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額。

ウ その他実費: 共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額。

SCRでは300mmウェハ在庫品の提供に際して、以下の料金を徴収しています。この金額は単価表改訂時のものであり、市場価格の変動により予告なく変更する場合があります。

・ウェハ(プロセスダミーグレード、リソグレード、通常在庫有): 20,000円/枚

◇運営管理費: 利用料金(共用施設等使用料、技術指導費等、追加料金の合計)額に15パーセントを乗じた額を運営管理費として加算させていただきます。(約款第6条第1項第6号)

◇消費税: 利用料金と運営管理費の合計額に消費税が加算されます。消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理いたします。